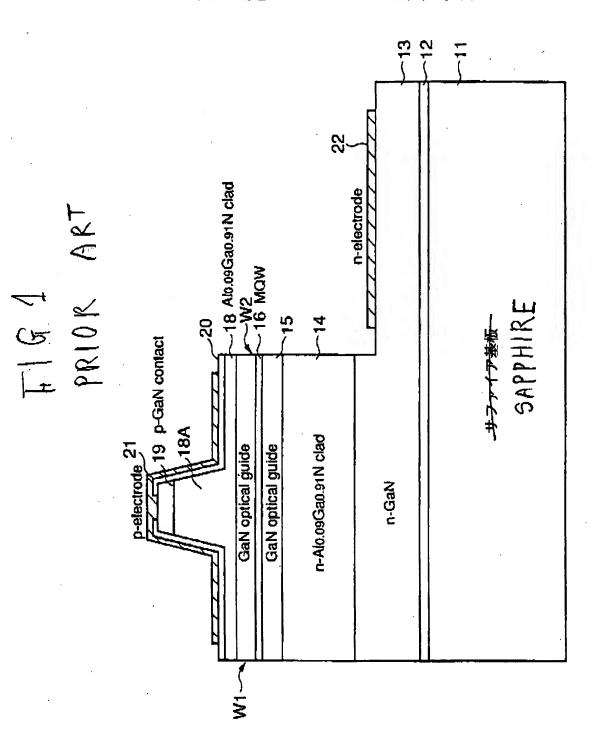
【書類名】 図面

[図1]

従来の青色レーザダイオードの構成を示す図

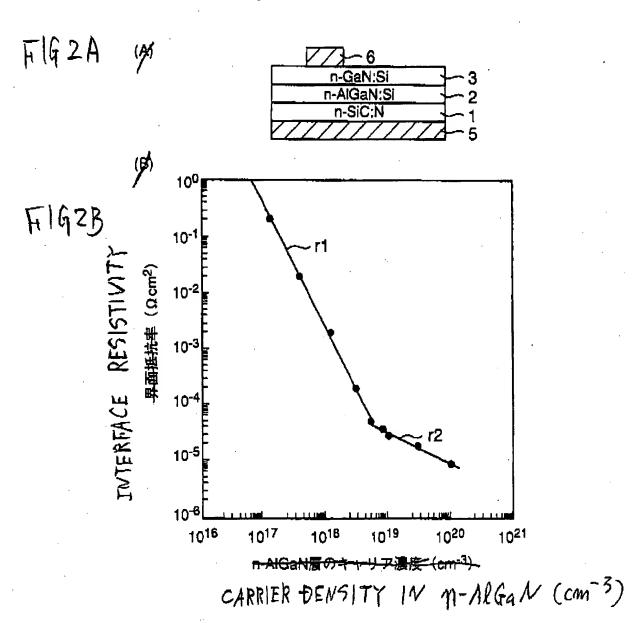


[図2]

H H will die den den he dies lage hate.

Hall Hall the rest con see.

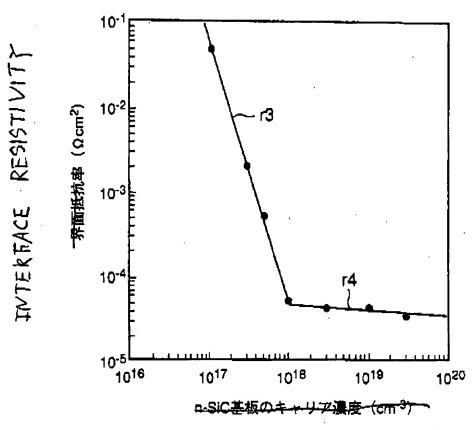
(A),(B)は、本発明の第1実施例の基礎となる実験で使われた試料、および実験結果を示す図



[図3]

FIG 3

本発明第1実施例の基礎となる実験の別の結果を示す図



CARRIER DENSITY IN M-SIC SUBSTRAT

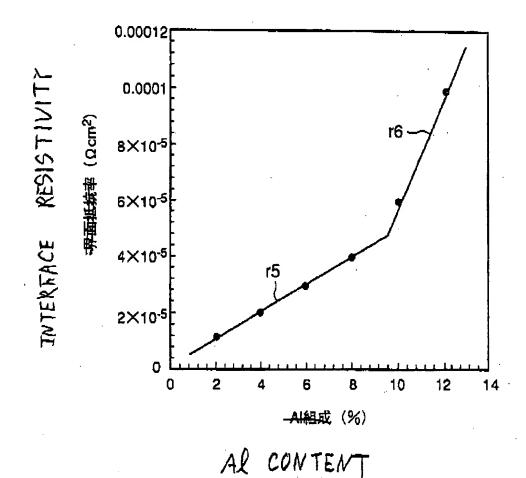
and the first the second that the second the second the second the second that the second the second that the second the

Ç.

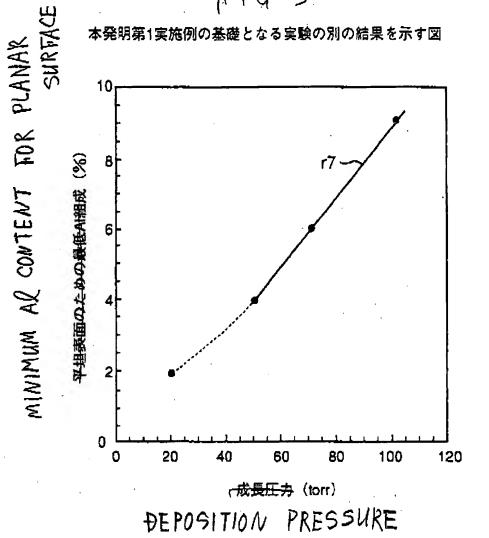
[図4]

FIGY

本発明第1実施例の基礎となる実験の別の結果を示す図



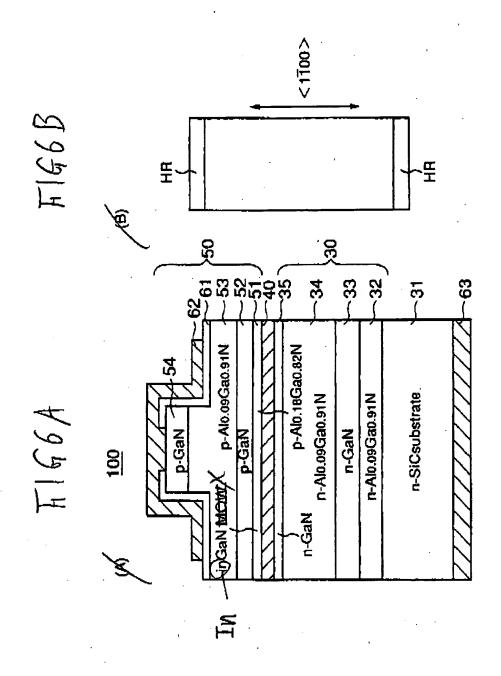
[図5]



Last find Cast to control tast

[図6]

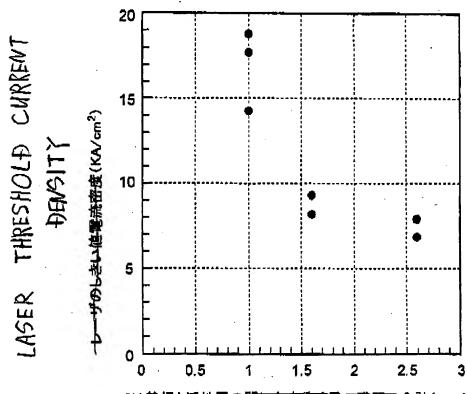
(A),(B)は、本発明の第1実施例によるレーザダイオードの 構成を示す図



[図7]

FIG 7

本発明の第2実施例の基礎となる実験の結果を示す図



Sic基板と活性層の間に存在する層の膜厚の含計 (μm)

TOTAL FILM THICKNESS BETWEEN

SIC SUBSTRATE AND ACTIVE LAYER

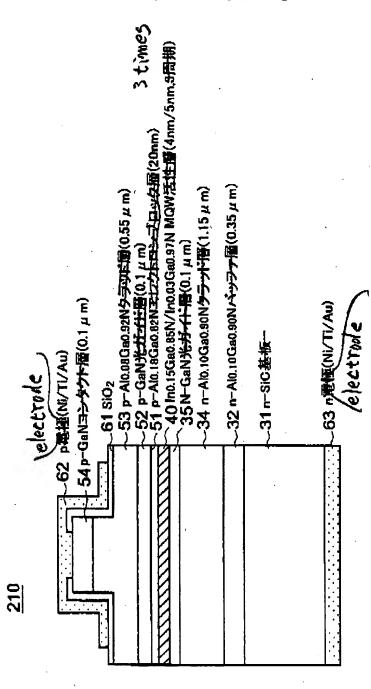
本発明の第2実施例によるレーザダイオードの構成を示す図

3 times -40 In0.15Ga0.85N/In0.03Ga0.97N MQW活柱層(4nm/5nm.9角粉) -35 n-GaN光が1作階(0.1 μ m) ~53 p-Alo.08Gao.92Nクラッド個(0.55 μm) ~52 p-GaN光ガイド暦(0.1 μm) ~51 p-Alo.18Gao.82N王セクトロンゴロック昭(20nm) .32 n-Alo.15Gao.85Nバシンプナ面(1.0 μm) 34 n-Ato.10Ga0.90Nタテンド面(1.5 μm) 54 p-GaNコンケン大師(0.1 x m) _63 n斯權(Ni/Ti/Au) electrode -31n-SiC基板 **61 SiO₂** 200

The first out over most of the first of the

[図9]

ドの一変形例を示す図

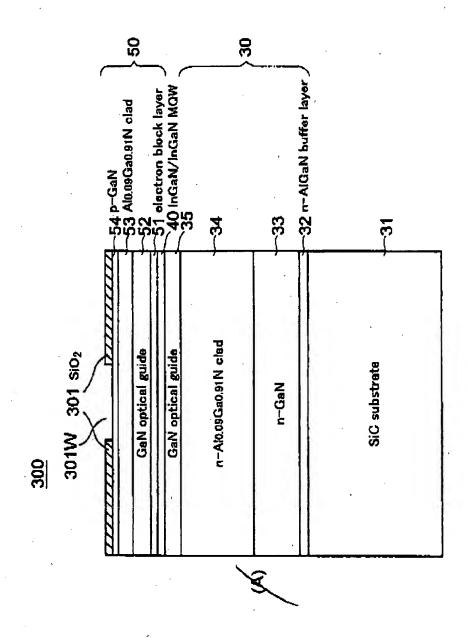


B. Line Silver of the state of

Ξì

[図10]

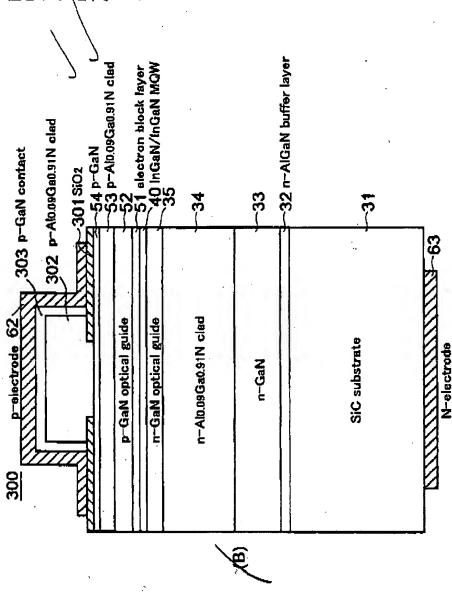
(A)は、本発明の第3実施例によるレーザダイオードの製造工程を示す図(その1)



F1910 A

【図11】

(B)は、本発明の第3実施例によるレ程を示す図(その2)

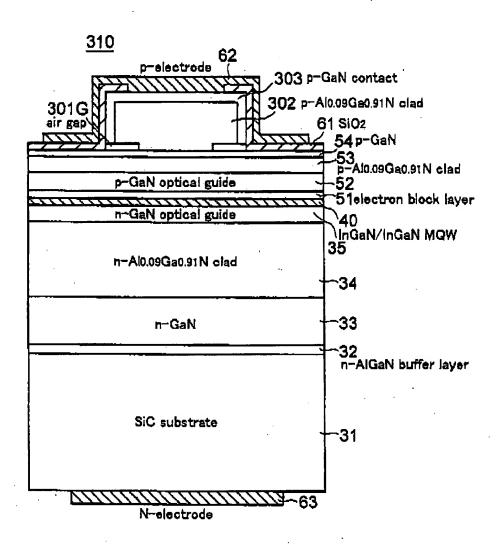


F1610B

[图12]

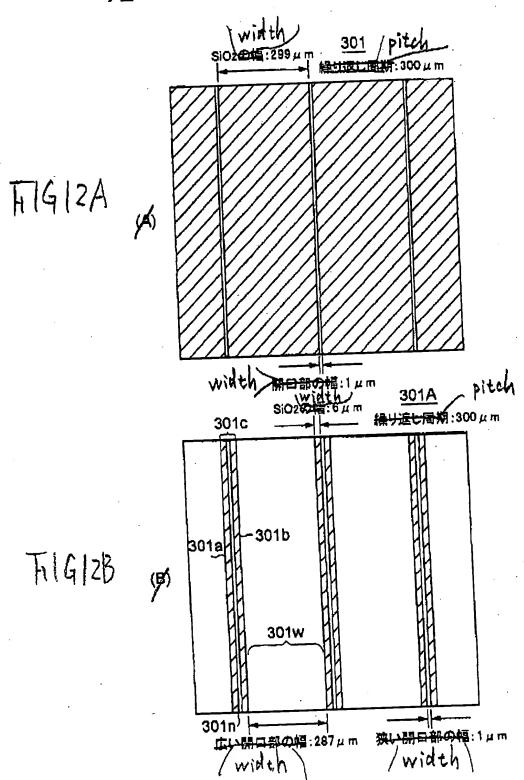
F1911

本発明第3実施例によるレーザダイオードの一変形例を示す図



المال المال المال متتما المتما المتما المال المتما المتما المتما المتما المال المال المتما المال المال المال ا

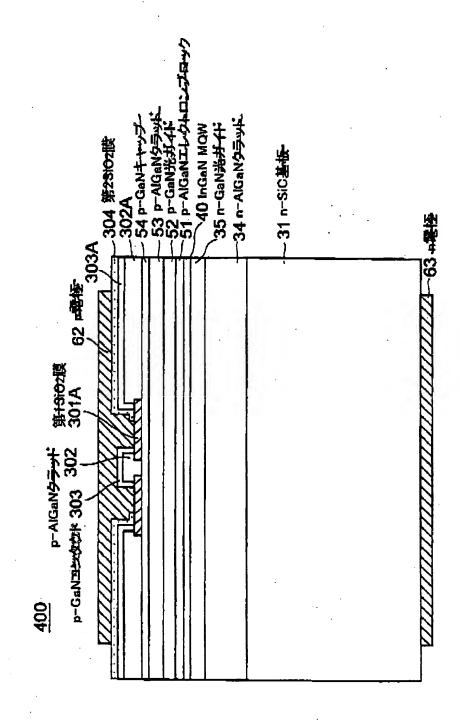
(A),(B)は、本発明第3実施例の選択成長工程で使われるマスク、 および本発明第4実施例の選択成長工程で使われるマスクを示 す図



The Rive And And 1,11 [5 I **ļ**:≟

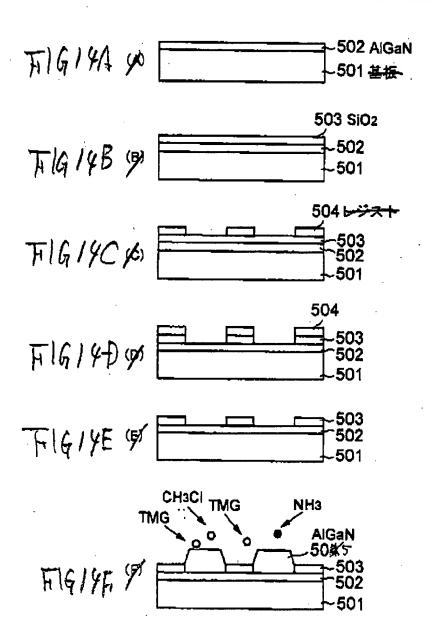
[図14]

本発明の第4実施例によるレーザダイオードの構成を示す図



The first of the second that I By the thin the time the first that the time to the time that the time that the time that the time the time that the time the time that the time the time that the time that the time that the time that the time F1613

(A)~(F)は、本発明の第5実施例による選択成長工程を示す図

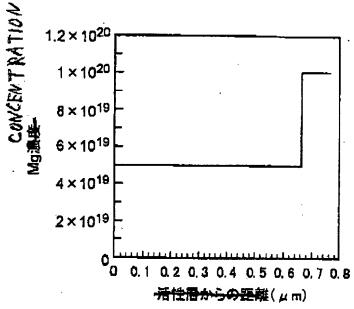


[216]

F1915

PRIOR ART

従来の青色レーザダイオードにおけるp型エピタキシャル層中の不純物分布を示す図

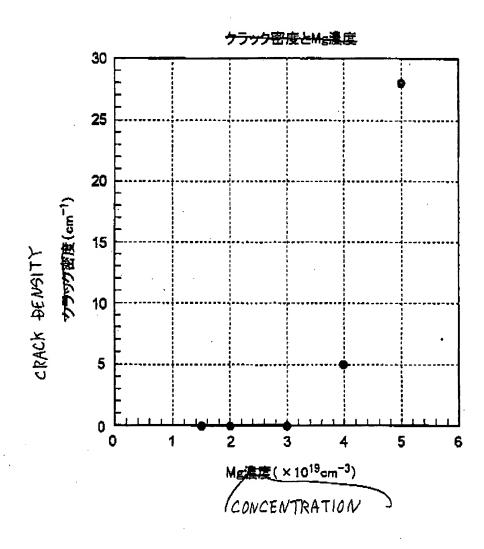


PISTANCE FROM ACTIVE LAYER

[図17]

F19/6

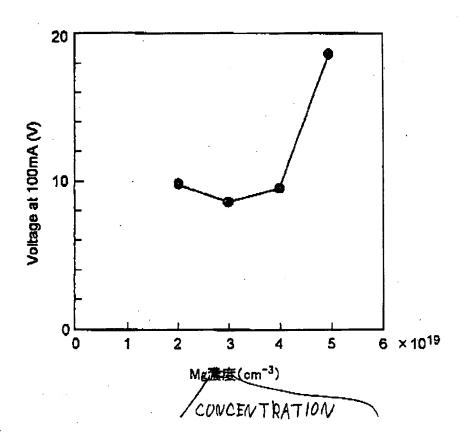
本発明の第6実施例の基礎となる実験結果を示す図



[図18]

F1917

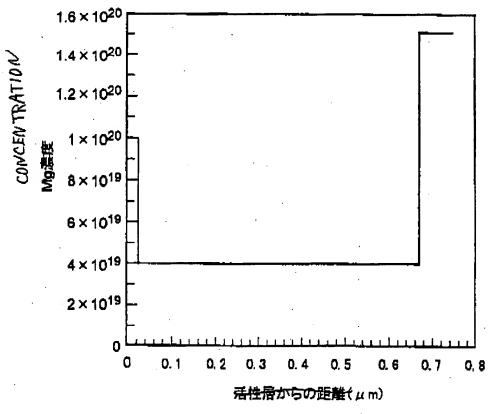
本発明第6実施例の基礎となる実験結果を示す別の図



[図19]

F1918

本発明の第6実施例によるレーザダイオードで使われる 不純物分布を示す図



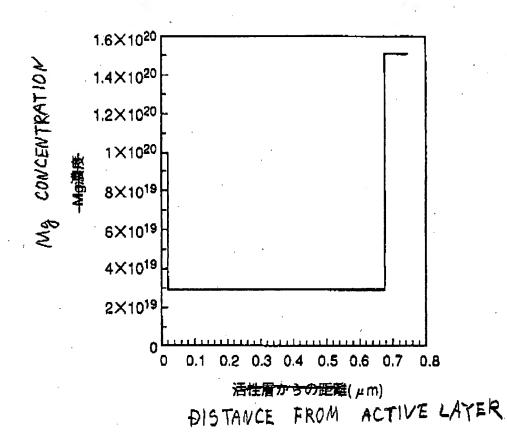
DISTANCE FROM ACTIVE LATER

- 1

[図20]

FIG19

図19の一変形例による不純物分布を示す図



والمرا الميا الميا